α-Fe 下地を用いた MgAl₂O₄基板上へのα'-Fe-N のエピタキシャル成長

Epitaxial growth of $\alpha\text{'-Fe-N}$ films on $\alpha\text{-Fe}$ buffered MgAl_2O4(001) substrate

^O東小薗創真 ¹、伊藤啓太 ^{1,2,3}、具志俊希 ¹、都甲薫 ¹、末益祟 ¹

(筑波大 数理物質 ¹、東北大 エ ²、学振 ³)

°S. Higashikozono¹, K. Ito^{1,2,3}, T. Gushi¹, K. Toko¹, and T. Suemasu¹

(1. Inst. of Appl. Phys., Univ. of Tsukuba, 2. Dept. of Electronic Eng., Tohoku Univ., 3. JSPS)

E-mail: bk201111036@s.bk.tsukuba.ac.jp

【背景】レアアースを用いない高飽和磁化強磁性材料として、α"-Fe₁₆N₂が注目されている¹⁻³。 我々はこれまでに、α-Fe 下地を挿入した、α"-Fe₁₆N₂と格子不整合の異なる MgO(001)(-3.9%), MgAl₂O₄(MAO)(001)(0.07%)基板上へのα'-Fe-N のエピタキシャル成長に成功している。しかし、 MAO 基板上でα-Fe 下地膜厚がα'-Fe-N の結晶性に与える影響は調べていない。本実験では、基板 上に 3, 10 nm のα-Fe 下地を敷き、その上にエピタキシャル成長したα'-Fe-N の結晶性を比較した。

【実験】分子線エピタキシー法により MgO(001), MAO(001)基板上へ固体 Fe を供給し、450 °C, 10 min のアニールを施しα-Fe 下地をエピタキシャル成長した。続いて、固体 Fe と高周波プラズマ N₂ を同時供給し、膜厚約 70 nm のα'-Fe-N をエピタキシャル成長した。Fe および N の供給条件は固 定し、α-Fe 下地の膜厚のみを変えた。Fe-N 層の成長時の基板温度は K-Cell の輻射により約 80 °C である。結晶性の評価はω-2θX 線回折(XRD)、 φ2θ_x XRD、反射高速電子線回折(RHEED)を用いた。

【結果・考察】Fig.1 に α -Fe 下地の RHEED 像を、Fig.2 に ω -2 θ XRD、Fig.3 に ϕ -2 θ_{χ} XRD パターン を示す。RHEED 像は、10 nm の α -Fe では基板による差は見られないが(Fig.1(a),(c))、3 nm の α -Fe は MgO 上でストリークが太くぼやけたのに対し(Fig.1(b))、MAO 上では鋭くなり菊池線が確認さ れた(Fig.1(d))。Fig.2,3 から、いずれの試料も α '-Fe-N がエピタキシャル成長している。 ω -2 θ XRD では、MAO 上の膜厚 3 nm の α -Fe(002)のピークのみが低角側に約 0.4°シフトし(Fig.2(d))、 α -Fe が 基板から圧縮歪みを受けていることを示唆している。これにより、バルクの α -Fe よりも α '-Fe-N の 格子定数に近く、かつ転位の少ない高品質な α -Fe 下地が形成されたと推察される。この上に作製 した α '-Fe-N の α '(002)のピーク強度は(Fig.2(d))、他の試料と比べ 3~10 倍になり(Fig.2(a)-(c))、ピー クの裾も狭くなったことから、 α '-Fe-N が高配向に成長したと考えられる。今後は試料をポストア ニールし、N が規則化した α "-Fe-N で飽和磁化が増大するか調べる。

【謝辞】本研究は、JSPS 科研費基盤 A(No. 26249037)の助成を受けた。

T. K. Kim and M. Takahashi., Appl. Phys. Lett. 20, 492 (1972). 2) T. Ogawa *et al.*, Appl. Phys. Express 6, 073007 (2013).
J. P. Wang *et al.*, IEEE Trans. Magn. 48, 1710 (2012).

